
2011 年 9 月 13 日

SiGe:C HBT NESG7030M04 产品规格

- 此产品为低噪声、高增益放大的理想选择

NF = 0.75 dB TYP., Ga = 14.0 dB TYP., @VCE = 2 V, Ic = 7 mA, f = 5.8 GHz

- 集电极击穿电压为 4.3 V 及以上
- 平引脚 4 引脚薄型超小型封装
- 无铅产品